Светочувствительные свойства тонких полупроводниковых пленок нанокомпозитов на основе металлорганических комплексов Cu⁺ и Ru²⁺

© Е.Л. Александрова, Н.Н. Химич*

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия * Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия

(Получена 6 апреля 2004 г. Принята к печати 19 апреля 2004 г.)

Исследованы светочувствительные свойства нанокомпозитов в системе "органический комплекс переходного металла" в матрице SiO₂. Показано, что светочувствительность нанокомпозита определяется валентностью и потенциалом ионизации атома металла и для комплекса Cu⁺ она составляет $(3-8) \cdot 10^4 \text{ см}^2/\text{Дж}$ (квантовый выход фотогенерации носителей заряда равен 0.03–0.05), а для комплекса Ru²⁺ — $5 \cdot 10^3 \text{ см}^2/\text{Дж}$. Возможность варьирования за счет структуры комплексов металлов величины светочувствительности и люминесценции тонких пленок нанокомпозитов на основе этих комплексов, а также увеличение квантового выхода фотогенерации путем введения в структуру нанокомпозита транспортных молекул позволяет надеяться на создание на их основе светочувствительных материалов и электролюминесцентных устройств.

1. Введение

Органо-неорганические нанокомпозиты [1] — один из наиболее интенсивно развиваемых в настоящее время разделов современного материаловедения — характеризуются явно выраженными полупроводниковыми свойствами. Благодаря возможности получения тонких прозрачных слоев оптического качества они представляются перспективными материалами для создания на их основе регистрирующих сред. В этой связи наибольший интерес среди данного класса нанокомпозитов представляют органические комплексы ряда переходных металлов с дипиридильными лигандами [2-5]. Такие композиты уже нашли практическое применение: они успешно используются в люминесцентных датчиках концентрации кислорода [5,6]. Наличие в таких композитах эффективного переноса заряда между атомом металла и органическим ароматическим лигандом позволяет надеяться на создание на их основе регистрирующих светочувствительных сред, в том числе фоторефрактивных — для голографии [7], а также материалов для фотовольтаических ячеек [8]. Благодаря их эффетивной люминесценции, спектральную область которой можно варьировать выбором атома металла [2-4,9], а также возможности введения в матрицу транспортных молекул, обеспечивающих эффективный перенос носителей заряда, эти композиты несомненно интересны как один из новых классов материалов для электролюминесцентных устройств.

Цель данной работы — изучение светочувствительных свойств нанокомпозитов в системе "органический комплекс переходного металла" в матрице SiO₂ и исследование механизма фотогенерации носителей заряда в них.

2. Объекты и методы исследования

Объектами исследования служили тонкие пленки, синтезированные на основе комплексов Cu^+ и Ru^{2+} с 2.2'-дипиридилом:



где X=-H и – CONH–(CH₂)₃–SiO– в матрице. Концентрация комплекса составляла 1–20%. В качестве матрицы использовались ксерогели SiO₂, синтезированные золь-гель-методом гидролитической поликонденсации тетраметоксисиланов в кислой среде [10]. Помимо указанных композитов матрица содержала свободные молекулы дипиридила, обеспечивающие перенос носителей заряда. Отжиг пленок производили при 300 и 500°С. Органические комплексы Cu⁺ и Ru²⁺ образовывали с матрицей SiO₂ наногибрид, причем в случае комплекса меди этот гибрид реализовывался за счет молекулярного взаимодействия компонентов [11], а в случае комплекса рутения — их химического связывания [12]. Толщина пленок составляла 1–2 мкм.

Измерения светочувствительности и квантового выхода фотогенерации носителей заряда η выполняли в электрофотографическом режиме по методике [13] в области спектра 400-800 нм при напряженности поля $E = (0.1-1.0)E_0$, где E_0 — предельная напряженность электрического поля для данного материала. По полевым зависимостям $\eta(E^{1/2})$ в соответствии с моделью Пула-Френкеля оценивали диэлектрическую проницаемость ε исходного ксерогеля и нанокомпозитов на основе комплексов металлов, а по модели Онзагера находили квантовый выход образования связанных пар η_0 и радиус термализации r_t . Спектры поглощения α измеряли на спектрофотометре Perkin Elmer. Светочувствительность $S_{0.1}$ определена по критерию спада поверхностного потенциала слоя (V) на 10% от начальной величины ($\Delta V/V = 0.1$) как при освещении монохроматическим светом, так и при освещении галогенной лампой КГМ-300 (интегральная светочувствительность).

3. Результаты и их обсуждение

Полученные нанокомпозиты, содержащие 1-20% комплексов металлов, имели структуру, представленную на рис. 1. Все композиты с содержанием комплекса до 15% включительно были монолитны и прозрачны. Увеличение твердости и прочности у образца с 10%-м содержанием комплекса по сравнению с исходным гелем, хотя и не очень значительное [11], свидетельствует о наличии определенного физического взаимодействия органического компонента с матрицей SiO₂. Оптимальная структура композита достигается при концентрации комплекса от 5 до 10%. Увеличение концентрации органического комплекса до 15% ведет к уменьшению плотности и твердости композита, а его 20%-я концентрация приводит к резкому падению твердости композита и потери им монолитности. Подобное изменение свойств синтезированных органо-неорганических гибридов можно объяснить на основе анализа их микрофотографий (рис. 1). Структура образца, содержащего 10% комплекса (рис. 1, b), подобна структуре исходного геля (рис. 1, a), хотя существенно более упорядочена, очевидно, за счет формирования нанокомпозита. Диаметр пор в обеих структурах составляет 10-17 нм. Структура композита с 20%-м содержанием комплекса более рыхлая и каналообразная (рис. 1, c). По-видимому, оптимальное содержание комплекса меди, ориентировочный размер молекул которого 1.0-1.5 нм, ограничено размером и количеством этих пор в матрице. Таким образом, в случае 10%-го содержания комплекса в композите его структура оптимальна, а введение большего числа молекул комплекса приводит к резкому ухудшению механических свойств и растрескиванию образца за счет образования матрицы SiO₂ в неоптимальных условиях.

Спектры поглощения $\alpha(\lambda)$ и светочувствительности $S_{0.1}(\lambda)$ пленок, содержащих нанокомпозиты с комплексами Cu⁺ и Ru²⁺ в матрице SiO₂, приведены на рис. 2, *а* и *b* (кривые *I* и *2* соответственно). На нем же для сравнения даны спектры исходного ксерогеля (кривые *3*). Из рис. 2, *а* видно, что максимум поглощения комплекса Cu⁺ соответствует 750 нм, т.е. находится в более длинноволновой области спектра по сравнению с максимумом для комплекса Ru²⁺, имеющим место при 450 нм, причем энергия максимума полосы поглощения (1.69 эВ для комплекса Cu⁺ и 2.76 эВ для ком-



Рис. 1. Электронные микрофотографии исходного ксерогеля (*a*) и нанокомпозитов с комплексами Cu⁺ (*b*, *c*) с различной концентрацией комплексов: *b* — 10% и *c* — 20%.

плекса Ru^{2+}) убывает по мере снижения валентности металла, что коррелирует с обнаруженным ранее [14] эффектом смещения максимума полосы поглощения в длинноволновую область при переходе от Me^+ к Me^{2+} , а также с уменьшением потенциала ионизации атома



Рис. 2. Спектры поглощения $\alpha(a)$ и светочувствительности $S_{0.1}$ (b) композитов на основе Cu⁺ (1) и Ru²⁺ (2) и исходного геля (3). Концентрация комплексов — 5%.

металла, что свидетельствует о переносе электрона с атома металла на лиганд.

Спектры люминесценции синтезированных нанокомпозитов, измеренные ранее [9] при возбуждении светом азотного лазера (с длиной волны 337 нм и длительностью импульса 6-8 нс), в течение времени послесвечения 1 мкс после импульса возбуждения при температуре $T = 300 \, \text{K}$, совпадают со спектрами аналогичных структур нанокомпозитов [3-6]. Для систем комплекс — SiO₂ независимо от температуры отжига максимум полосы люминесценции для комплекса Ru²⁺ — 610-620 нм, для комплекса Cu⁺ — широкая полоса около 420 нм. Интенсивность люминесценции комплекса Ru²⁺ более чем в 10 раз выше, чем комплекса Cu⁺. Наблюдаемая полоса люминесценции комплекса Си⁺, очевидно, обусловлена излучением лишь дипиридиловых фрагментов, поглощающих в области спектра 300-360 нм, а не комплекса с металлом, поглощающего, как видно из рис. 2, в более длинноволновой области спектра.

светочувствительности Спектры нанокомпозитов (рис. 2, b) повторяют спектры поглощения (рис. 2, a). Светочувствительность пленок нанокомпозита на основе Cu⁺ при концентрации комплекса 5-10% составляет (3-8) · 10⁴ см²/Дж, квантовый выход — 0.03-0.05. Для комплекса Ru²⁺ светочувствительность $S_{0,1}$ находится на уровне $5 \cdot 10^3$ см²/Дж в области спектра 400-550 нм, а квантовый выход $\eta \approx 0.003 \pm 0.001$, что более чем на порядок ниже, чем для комплекса Си⁺. Светочувствительность слоев исходного ксерогеля находится на уровне $2 \cdot 10^3 \, \text{см}^2/\text{Дж}$, а квантовый выход $\eta \approx 0.001$. Радиус термализации для комплекса Cu^+-SiO_2 составляет $r_t = 1.5 \pm 0.2$ нм, что сравнимо с размерами молекулы комплекса (1.0–1.5 нм)

Физика и техника полупроводников, 2004, том 38, вып. 11

и несколько ниже (на 25%), чем для полимерных комплексов аналогичной структуры [15]. Квантовый выход образования связанных пар $\eta_0 = 0.08 \pm 0.03$.

Корреляция спектров поглощения и светочувствительности изученных систем, а также возрастание люминесцентных свойств по мере снижения величины S_{0.1} (при переходе от комплекса Cu⁺ к комплексу Ru²⁺) свидетельствуют об участии в первичных фотофизических процессах молекулы комплекса $[CuL_2]^+$ или $[RuL_3]^{2+}$, в которой при поглощении фотона происходит перенос электрона с атома металла на лиганд. В пределах этой же молекулы происходит и потеря избыточной энергии фотона и термализация кулоновски связанного носителя заряда. Дальнейшее разделение зарядов осуществляется в результате термополевой диссоциации во внешнем электрическом поле. Носители становятся свободными на расстояниях 10–15 нм. Это расстояние (кулоновский радиус) рассчитано по величине диэлектрической проницаемости є, равной для комплексов 6.5-7.0, а для исходного ксерогеля $\varepsilon = 6.0 \pm 0.5$.

Энергия максимума полосы поглощения $\hbar\omega$ для комплекса определяется, как показано выше, атомом металла. Варьирование же лиганда от дипиридила к дихинолилу и производным фенантролина для комплексов Ru²⁺-SiO₂ смещает энергию первой полосы переноса заряда с 4.64 эВ (для дипиридила) до 4.47 эВ (для нитрофенантролина), 4.19 эВ — для аминофенантролина и 3.87 эВ — для фенантролин-5.6-диона [16]. Наличие свободных (не образующих комплексы с металлом) молекул дипиридила позволяет получить довольно высокие значения светочувствительности, превосходящие S_{0.1} для близких по структуре металлорганических комплексов тех же металлов в полимерной матрице [15], и, по-видимому, величины подвижности носителей заряда, достигаемой за счет перескоков свободных носителей заряда по ароматическим азотсодержащим молекулам дипиридила.

4. Заключение

Таким образом, показано, что использование матрицы SiO_2 позволяет получить довольно высокие значения светочувствительности для тонких пленок нанокомпозитов, содержащих металлогранические комплексы, превосходящие величины $S_{0.1}$ для близких по структуре комплексов тех же металлов в полимерной матрице. При этом обнаружение эффективной люминесценции нано-композитов в матрице SiO_2 , максимум полосы которой можно варьировать как выбором атома металла [9], так и структуры лиганда (замена дипиридина на бихинолин или фенантролин, также способных к комплексообразованию с металлами, и др.) позволяет надеяться на создание на их основе не только светочувствительных материалов, но и электролюминесцентных устройств.

Список литературы

- [1] А.Д. Помогайло. Успехи химии, 69, 60 (2000).
- [2] F.N. Castellano, T.A. Heimer, G.J. Meyer. Chem. Mater., 6, 1041 (1994).
- [3] K. Matsui, F. Momose. Chem. Mater., 9, 2588 (1997).
- [4] F. Momose, K. Maedo, K. Matsui. J. Non-Cryst. Sol., 244, 74 (1999).
- [5] В.И. Земский, А.В. Вересов, Л.Ю. Колесников. Письма ЖТФ, 20 (9), 74 (1994).
- [6] M. Ahmat, N. Mohammad, J. Abdullah. J. Non-Cryst. Sol., 290, 86 (2001).
- [7] Z. Peng, A.R. Charavi, L. Yu. Appl. Phys. Lett., 69 (26), 4002 (1996).
- [8] S.C. Yu, X. Gong, W.K. Chan. Macromolecules, 31, 5639 (1998).
- [9] Е.Л. Александрова, М.Е. Компан, Н.Н. Химич. Тез. докл. межд. конф. "Аморфные и микрокристаллические полупроводники" (СПб, 2004) с. 194.
- [10] Н.Н. Химич, Б.И. Вензель, И.А. Дроздова, Л.А. Коптелова. ЖПХ, 75 (7), 1125 (2002).
- [11] Н.Н. Химич, Е.Л. Александрова, В.Я. Гойхман, Л.А. Коптелова. Физика и химия стекла, 29 (4), 555 (2003).
- [12] Н.Н. Химич, М.П. Семов, Л.Ф. Чепик. ДАН, **394** (1), 1 (2004).
- [13] Е.Л. Александрова, Ю.А. Черкасов. Опт. и спектр., 64 (5), 1047 (1988).
- [14] Y. Mori, K. Maeda. J. Chem. Soc., Perkin Trans., 2, 1969 (1997).
- [15] Е.Л. Александрова, М.Я. Гойхман, В.В. Кудрявцев и др. Опт. журн., 68 (11), 67 (2001); ФТП, 37 (7), 846 (2002).
- [16] R.D. Gillard, R.E. Hill. J. Chem. Soc., 11, 1217 (1974).

Редактор Т.А. Полянская

The photosensitivity of thin nanocomposite semiconductor layers based on Cu⁺ and Ru²⁺ metal-organic complexes

E.L. Alexandrova, N.N. Khimich*

Ioffe Physicotechnical Institute, Russian Academy of Sciences, 194021 St. Petersburg, Russia * Grebenschikov Institute for Silicate Chemistry, Russian Academy of Sciences, 194021 St. Petersburg, Russia